

B-2 次の記述は、電界効果トランジスタ(FET)について述べたものである。□内に入れるべき字句を下の番号から選べ。

- (1) トランジスタを大別するとバイポーラトランジスタとユニポーラトランジスタの二つがあり、このうちFETは ア トランジスタに属する。また、FETの構造が、金属 - 酸化膜(絶縁物) - 半導体により構成されているものを イ 形FETという。
- (2) シリコン半導体に代わり、化合物半導体の ウ を用いたFETは、電子移動度が エ、オ 特性が優れているため、マイクロ波の高出力増幅器等に広く用いられている。

ユニポーラ

ガリウムヒ素(GaAs)

大きく 高周波MOS

ア 8, 1, 2, 4, 10, エ 9, オ 1

- |       |       |         |       |                        |
|-------|-------|---------|-------|------------------------|
| 1 高周波 | 2 MOS | 3 バイポーラ | 4 小さく | 5 ニッケルカドミウム(NiCd)      |
| 6 低周波 | 7 接合  | 8 ユニポーラ | 9 大きく | 10 <u>ガリウムヒ素(GaAs)</u> |

